

Кремниевый фотодетекторный чип 1.52×1.52 мм — техническое описание

P/N: WS9L-10B

Применение

Si NIP фотодиодные чипы

Структура

Планарная структура: NIP-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	53 × 53			мил
Ширина чипа	60 × 60 (± 1.0)			мил
Длина чипа	60 × 60 (± 1.0)			мил
Высота чипа	12 (± 1.0)			мил
Контактная площадка катода	15.6 × 9.2			мил
Контактная площадка анода	15.6 × 9.2			мил

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.7		1.3	В
Обратное напряжение	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λр			940		нм
Емкость	CJ	VR=3V, F=1 MHz		25		пФ

Ед.: мил

